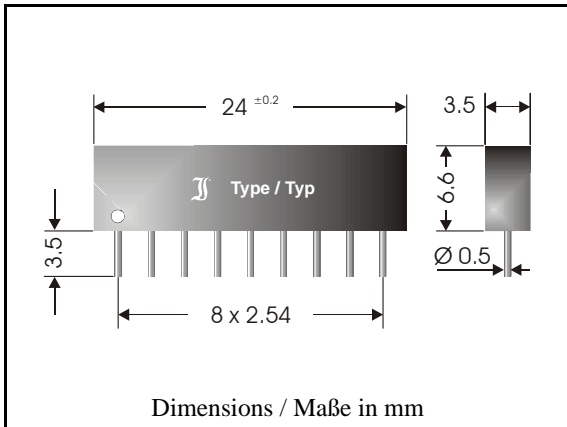


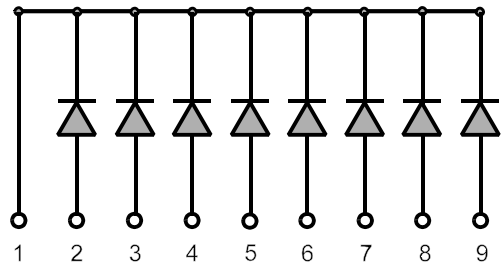
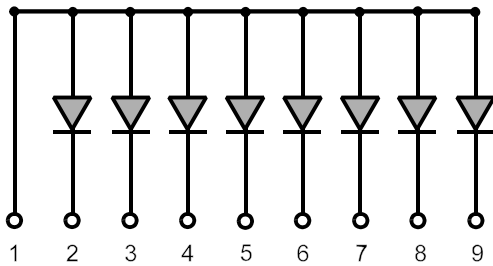
Small Signal Diode Arrays

Dioden Sätze mit Allzweckdioden

Version 2004-10-01



Nominal power dissipation 200 mW
 Nenn-Verlustleistung
 Repetitive peak reverse voltage 80 V
 Periodische Spitzensperrspannung
 9 Pin-Plastic case 24 x 3.5 x 6.6 [mm]
 9 Pin-Kunststoffgehäuse
 Weight approx. – Gewicht ca. 0.6 g
 Standard packaging: bulk
 Standard Lieferform: lose im Karton



"DAP": common anodes / gemeinsame Anoden
 "DA4148A": common anodes / gemeinsame Anoden

"DAN": common cathodes / gemeinsame Kathoden
 "DA4148K": common cathodes / gemeinsame Kathoden

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DAN803 = DA4148 K	80	80
DAP803 = DA4148 A	80	80

Max. average forward rectified current, R-load, for one diode operation only per diode for simultaneous operation	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV} 100 mA ¹⁾ I_{FAV} 25 mA ¹⁾
Dauergrenzstrom in Einwegschtaltung mit R-Last, für eine einzelne Diode pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV} 100 mA ¹⁾ I_{FAV} 25 mA ¹⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM} 500 mA

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_j – 50...+150°C
 T_s – 50...+150°C

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10\text{ mA}$	V_F	< 1.0 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20\text{ V}$	I_R	< 25 nA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to/auf $I_R = 1\text{ mA}$		t_{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 85 K/W ¹⁾

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten